Содержание	• Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления
TT	Жуков Н.Д., Гавриков М.В., Штыков С.Н.
• Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)	Размерное моделирование синтеза и проводимости колло- идных квантовых точек
Anisimov A.N., Breev I.D., Likhachev K.V., Kazarova O.P., Nagalyuk S.S., Baranov P.G., Hübner R., Astakhov G.V., Ber B.Ya., Kazantcev D.Yu., Scheglov M.P., Mokhov E.N.	• Аморфные, стеклообразные, органические полупровод- ники
The effect of liquid Silicon on the AlN crystal growth 527	Кастро Арата Р.А., Грабко Г.И., Кононов А.А., Ани- симова Н.И., Крбал М., Колобов А.В.
• Электронные свойства полупроводников	Поляризационные процессы в тонких слоях стеклообразной гибридной системы $Ge_{28.5}Pb_{14.0}Fe_{1.0}S_{56.5}$ 559
Зикриллаев Х.Ф., Аюпов К.С., Мавлонов Г.Х., Усмонов А.А., Шоабдурахимова М.М.	пол тнорядной системы СС28.51 014.01 С1.0056.5
Особенности электрофизических параметров кремния, легированного последовательно примесными атомами фосфора и бора	• Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники
Rozina Ch., Maryam N.	Турсынбаев С.А.
Low frequency Compressional modes in degenerate semiconductor plasmas	Влияние освещенности и температуры на тензосвойства кремния с нанокластерами атомов марганца 566
• Спектроскопия, взаимодействие с излучениями	Затонская Л.В., Смагин В.П., Харнутова Е.П., Игна- тов Е.В.
Когай В.Я., Могилева Т.Н., Фатеев А.Е., Михеев Г.М.	Фотолюминесценция сульфида цинка, легированного ионами Mn^{2+} и Eu^{3+} в среде додекана 570
Фазовые превращения в композитных пленках системы Se-Cu, полученных взрывной кристаллизацией и термическим отжигом	Болотов В.В., Князев Е.В., Пономарева И.В., Ивлев К.Е.
Benemanskaya G.V., Timoshnev S.N., Iluridze G.N., Minashvili T.A.	Многослойная сенсорная структура на основе пористого кремния
Synchrotron radiation photoemission study of the electronic structure of the ultrathin K/AlN interface	Холяво И.И., Хомец А.Л., Сафронов И.В., Фило- нов А.Б., Мигас Д.Б.
Соболев Н.А., Калядин А.Е., Штельмах К.Ф., Шек Е.И., Сахаров В.И., Серенков И.Т.	Влияние морфологии на фононную теплопроводность нанопроволок Si, Ge и Si/Ge типа ядро/оболочка 580
Эффективность возбуждения центров дислокационной люминесценции в кремнии с кислородными преципитатами 542	Гапанович М.В., Один И.Н., Левин И.М., Раки- тин В.В., Седловец Д.М., Шилов Г.В., Корчагин Д.В.
Sulimov M.A., Sarychev M.N., Mogilnikov I.A., Ivanov V.Yu., Volkov V.A., Zhivulko V.D., Mudryi A.V., Yakushev M.V. Irradiation of Cu(In, Ga)Se ₂ Thin Films by 10 MeV Electrons	Исследование кристаллической структуры, оптических и электрофизических свойств нового полупроводникового материала Cu ₂ CrSnS ₄ для тонкопленочных солнечных элементов
at 77 K: Effect on Photoluminescence Spectra 546	
• Поверхность, границы раздела, тонкие пленки	• Физика полупроводниковых приборов
Середин П.В., Радам Али Обаид, Голощапов Д.Л.,	Александров О.В.
Леньшин А.С., Буйлов Н.С., Барков К.А., Нестеров Д.Н., Мизеров А.М., Тимошнев С.Н., Никитина Е.В., Арсентьев И.Н., Шарофидинов Ш., Вави-	Размерный эффект в МОП-структурах при ионизирующем облучении
лова Л.С., Кукушкин С.А., Касаткин И.А.	Иванов А.М., Клочков А.В.
Рост тонкопленочных AlGaN/GaN эпитаксиальных гетероструктур на гибридных подложках, содержащих слои карбида кремния и пористого кремния	Влияние низкой температуры на электрофизические и шу- мовые характеристики ультрафиолетовых светодиодов на основе структур с квантовыми ямами InGaN/GaN 596

6* 611

612 Содержание

Бабичев А.В., Михайлов Д.А., Чистяков Д.В., Колодезный Е.С., Гладышев А.Г., Вознюк Г.В., Митрофанов М.И., Денисов Д.В., Слипченко С.О., Лютецкий А.В., Дюделев В.В., Евтихиев В.П., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Пихтин Н.А., Егоров А.Ю., Соколовский Г.С.
Исследование пространственных характеристик излучения поверхностно-излучающих квантово-каскадных лазеров с кольцевым резонатором
Афанасьев А.В., Ильин В.А., Лучинин В.В., Сер- ков А.В., Чигирев Д.А.
О формировании низкоомных контактов для биполярных приборов на основе $4H$ -SiC